

1564TM8 ЭП

Аналог 54HC175.

Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами.

Технология – КМОП Змкм процесс.

Технические условия исполнения АЕЯР.431200.424-18ТУ.

Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Основные характеристики:

Диапазон напряжений питания от 2 В до 6 В.

Предельное напряжение питания до 7 В.

Диапазон рабочих температур от -60 °C до + 125 °C.

Максимальная тактовая частота ≤ 35 МГц при U_{CC} = 6 В, C_L = 50 пФ, T = 25 °C.

Выходное напряжение низкого уровня ≤ 0,26 В при U_{CC} = 6 В, I_O = 5,2 мА, T = 25 °C.

Выходное напряжение высокого уровня ≥ 5,48 В при U_{CC} = 6 В, I_O = 5,2 мА, T = 25 °C.

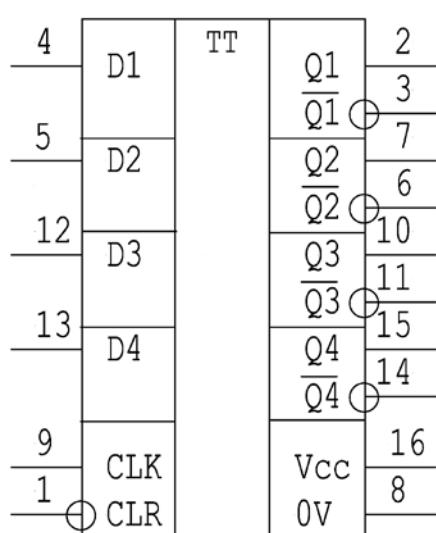
Предельное знач. входного и выходного напряжений от -0,5 В до (U_{CC} + 0,5) В.

Стойкость к воздействию специфакторов по группам исполнения:

7.I₁-3Y_C, 7.I₆-2Y_C, 7.I₇-5Y_C, 7.C₁-1Y_C, 7.C₄-5Y_C, 7.K₁-1K, 7.K₄-1K для диапазона напряжения питания от 2 В до 6 В.

7.I₁-3Y_C, 7.I₆-2x5Y_C, 7.I₇-5Y_C, 7.C₁-4Y_C, 7.C₄-5Y_C, 7.K₁-1K, 7.K₄-1K для диапазона напряжения питания от 3 В до 6 В.

Рис. 1. Условное графическое обозначение микросхем 1564TM8 ЭП.



Т а б л и ц а 1. Назначение выводов микросхем 1564TM8 ЭП.

№ вывода	Обозначение вывода (в соответствии со схемой электрической)	Назначение вывода
1	CLR	CLR
2	Q1	Выход первого триггера
3	$\overline{Q1}$	Выход инверсный первого триггера
4	D1	Вход первого триггера
5	D2	Вход второго триггера
6	$\overline{Q2}$	Выход инверсный второго триггера
7	Q2	Выход второго триггера
8	0V	Общий
9	CLK	Вход тактовый
10	Q3	Выход третьего триггера
11	$\overline{Q3}$	Выход инверсный третьего триггера
12	D3	Вход третьего триггера
13	D4	Вход четвертого триггера
14	$\overline{Q4}$	Выход инверсный четвертого триггера
15	Q4	Выход четвертого триггера
16	V _{CC}	Питание

Т а б л и ц а 2. Таблица истинности микросхем 1564ТМ8 ЭП.

Входы			Выходы	
CLR	CLK	D	Q	\bar{Q}
L	X	X	L	H
H	↑	H	H	L
H	↑	L	L	H
H	L	X	Q0	$\bar{Q}0$

H - высокий уровень;
L - низкий уровень;
X - любое состояние;
↑ - переход с низкого уровня на высокий;
Q0, $\bar{Q}0$ - предыдущее состояние.

Т а б л и ц а 3. Электрические параметры микросхем 1564ТМ8 ЭП при приемке и поставке.

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Темпера- тура среды, °C
		не менее	не более	
1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC} = 2,0 \text{ В}, U_{IL} = 0,3 \text{ В}, U_{IH} = 1,5 \text{ В}, I_O = 20 \text{ мкА}$ $U_{CC} = 4,5 \text{ В}, U_{IL} = 0,9 \text{ В}, U_{IH} = 3,15 \text{ В}, I_O = 20 \text{ мкА}$ $U_{CC} = 6,0 \text{ В}, U_{IL} = 1,2 \text{ В}, U_{IH} = 4,2 \text{ В}, I_O = 20 \text{ мкА}$	$U_{OL\ max}$	-	0,10 0,10 0,10	25±10, -60, 125
		-	0,26 0,40 0,40	25±10 -60 125
		-	0,26 0,40 0,40	25±10 -60 125
	$U_{OH\ min}$	1,9 4,4 5,9	-	25±10, -60, 125
		3,98 3,7 3,7	-	25±10 -60 125
		5,48 5,20 5,20	-	25±10 -60 125
		5,48 5,20 5,20	-	25±10 -60 125
		5,48 5,20 5,20	-	25±10 -60 125
		5,48 5,20 5,20	-	25±10 -60 125
3. Входной ток низкого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 6,0 \text{ В},$ $U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{IL}	-	/ -0,1/ / -0,1/ / -1,0/	25±10 -60 125
4. Входной ток высокого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 6,0 \text{ В},$ $U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{IH}	-	0,1 0,1 1,0	25±10 -60 125
5. Ток потребления ,мкА, при: $U_{CC} = 6,0 \text{ В},$ $U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 \text{ В}$	I_{CC}	-	8,0 160 160	25±10 -60 125
6. Динамический ток потребления, мА, при: $U_{CC} = 6,0 \text{ В}, f = 1,0 \text{ МГц}$	I_{OCC}	-	0,75	25±10
7. Максимальная тактовая частота, МГц, при: $U_{CC} = 2,0 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	$f_{C\ max}$	6 4 4	-	25±10 -60 125
		30 20 20	-	25±10 -60 125
		35 24 24	-	25±10 -60 125

Продолжение таблицы 3.

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Темпера- тура среды, °C
		не менее	не более	
8. Время задержки распространения при включении (выключении), нс, при: $U_{CC} = 2,0 \text{ В}$, $C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL1} (t_{PLH1}), t_{PHL2} (t_{PLH2})	-	210 225 225	25 ± 10 -60 125
		-	42 45 45	25 ± 10 -60 125
		-	37 50 50	25 ± 10 -60 125
	t_{PHL3} (t_{PLH3})	-	175 242 242	25 ± 10 -60 125
		-	35 49 49	25 ± 10 -60 125
		-	30 42 42	25 ± 10 -60 125
9. Входная емкость, пФ, при: $U_{CC} = 0 \text{ В}$	C_I	-	15,0 (вывод 9)	25 ± 10
			10,0 (выводы 1, 4, 5, 12, 13)	

t_{PHL1} , t_{PLH1} – от входа CLK к выходам Q,
 t_{PHL2} , t_{PLH2} – от входа CLK к выходам \bar{Q} ,
 t_{PHL3} , t_{PLH3} – от входа CLR к выходам Q и \bar{Q} .

Т а б л и ц а 4. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем 1564ТМ8 ЭП.

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра				Время воздействия предельного режима эксплуатации
		предельно допустимый режим		предельный режим		
		не менее	не более	не менее	не более	
Напряжение питания, В	U _{CC}	2,0	6,0	минус 0,5	7,0	–
Входное напряжение, В	U _I	0	U _{CC}	минус 0,5 минус 1,5	U _{CC} + 0,5 U _{CC} + 1,5	–
Напряжение подаваемое на выход, В	U _O	0	U _{CC}	минус 1,5 минус 0,5	U _{CC} + 1,5 U _{CC} + 0,5	5 мс
Ток через один любой вход, мА	I	–	–	–	20	–
Ток через один любой выход, мА	I _O	–	5,2	–	25	–
Ток постоянный (средний) через вывод V _{CC} и «общий», мА	I _I	–	–	–	50	–
Рассеиваемая мощность, мВт	P _{tot}	–	–	–	400 ¹⁾	–
Длительность фронта и спада входного сигнала, нс, при: U _{CC} = 2,0 В U _{CC} = 4,5 В U _{CC} = 6,0 В	τ _ф , τ _{сп}	– – –	6 ²⁾ 6 ²⁾ 6 ²⁾	– – –	1000 ³⁾ 500 ³⁾ 400 ³⁾	– – –
Емкость нагрузки, пФ	C _L	–	50 ²⁾	–	500	–

¹⁾ В диапазоне температур от минус 60 до 100 °C. В диапазоне температур от 100 до 125 °C норма снижается с коэффициентом 12 мВт/ °C.

²⁾ При измерении динамических параметров.

³⁾ Динамические параметры не регламентируются.

Наработка микросхем до отказа Т_н в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температура эксплуатации) не более (65 + 5) °C не менее 100000 ч, а в облегченном режиме: при U_{CC} = 5 В ± 10 % - не менее 120000 ч.

Масса микросхем: не более 1,7 г.

Варианты конструктивного исполнения для поставок заказчику:

- в корпусе типа 402.16-33.03 с золотым покрытием (1564ТМ8Т ЭП);
- в корпусе типа 402.16-33НБ с никелевым покрытием (1564ТМ8Т1 ЭП);
- кристаллы без корпуса и без выводов.

Возможно иное исполнение по требованиям Заказчика.

Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку)

1564ТМ8Т ЭП – АЕЯР.431200.424-18ТУ.

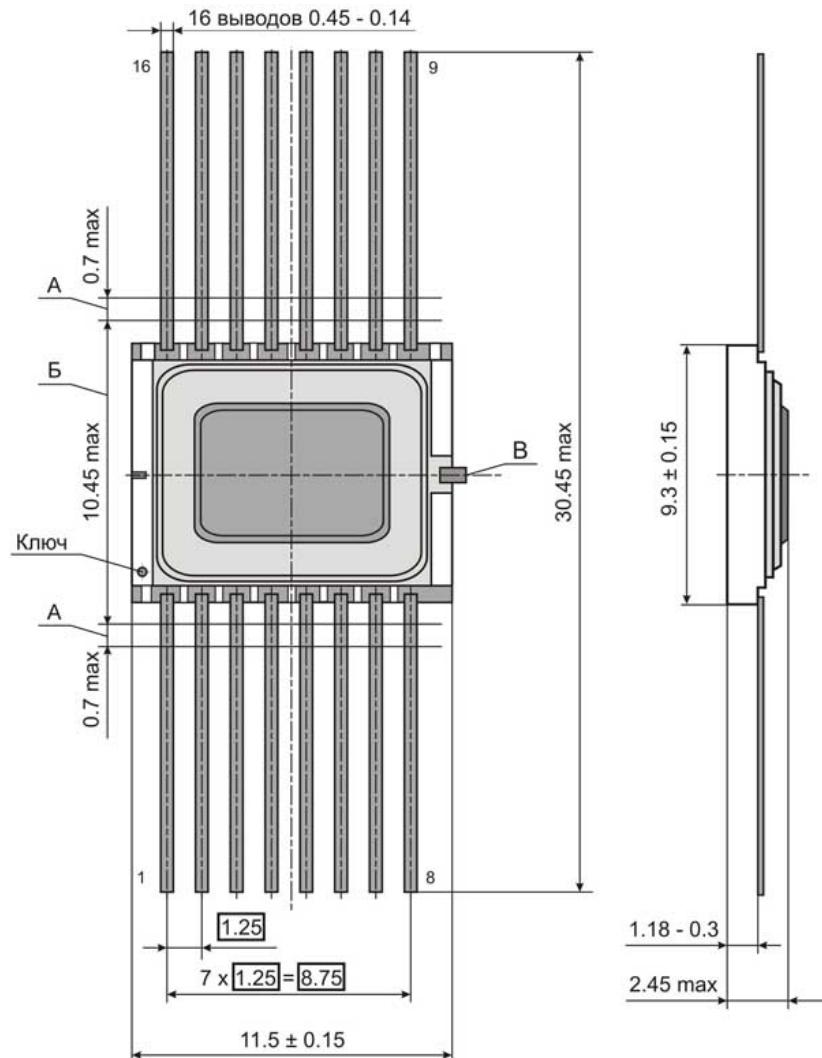
При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»:

1564ТМ8Т ЭП – АЕЯР.431200.424-18ТУ, А.

Обозначение микросхем при заказе в бескорпусном исполнении на общей пластине:

Б1564ТМ8-4 ЭП – АЕЯР.431200.424-18ТУ.

Рис. 2. Корпус 402.16-33
размеры в миллиметрах.



А - длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
В - допускается поставка изделий без технологической перемычки В по согласованию с потребителями.

Для более полной информации о микросхеме использовать АЕЯР.431200.424ТУ и АЕЯР.431200.424-18ТУ, КСНЛ.431253.005Э3, КСНЛ.431253.005ТБ1.